



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104119864 A

(43) 申请公布日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201310150177. 5

(22) 申请日 2013. 04. 26

(71) 申请人 海洋王照明科技股份有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区南海大道
海王大厦 A 座 22 层

申请人 深圳市海洋王照明技术有限公司
深圳市海洋王照明工程有限公司

(72) 发明人 周明杰 陈吉星 王平 张振华

(74) 专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
44202

代理人 郝传鑫 熊永强

(51) Int. Cl.

C09K 11/59 (2006. 01)

H01L 51/54 (2006. 01)

H01L 51/56 (2006. 01)

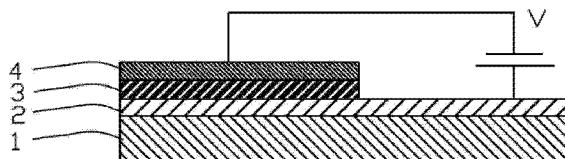
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

钐掺杂氮化硅发光材料、制备方法及其应用

(57) 摘要

一种钐掺杂氮化硅发光材料，其化学式为 $Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$ ，其中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质，钐离子是激活元素， x 为 $0.01 \sim 0.05$ ， Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。该钐掺杂氮化硅发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱 (EL) 中，在 $638nm$ 和 $727nm$ 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该钐掺杂氮化硅发光材料的制备方法及其应用。



1. 一种钐掺杂氮化硅发光材料,其特征在于:其化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

2. 一种钐掺杂氮化硅发光材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀,其中, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;及

将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时即得到化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 的钐掺杂氮化硅发光材料。

3. 一种钐掺杂氮化硅发光薄膜,其特征在于,该钐掺杂氮化硅发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

4. 一种钐掺杂氮化硅发光薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时制成靶材,其中, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;

将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体,并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$;及

调整磁控溅射镀膜工艺参数为:基靶间距为 $45\text{mm} \sim 95\text{mm}$,磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 4\text{Pa}$,工作气体的流量为 $10\text{sccm} \sim 35\text{sccm}$,衬底温度为 $250^\circ\text{C} \sim 750^\circ\text{C}$,溅射功率 $80 \sim 300\text{W}$,接着进行制膜,得到化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 的钐掺杂氮化硅发光薄膜。

5. 根据权利要求 4 所述的钐掺杂氮化硅发光薄膜的制备方法,其特征在于,所述 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为 $2:5:(0.03 \sim 0.15)$ 。

6. 根据权利要求 4 所述的钐掺杂氮化硅发光薄膜的制备方法,其特征在于,所述真空腔体的真空度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$,基靶间距为 60mm ,磁控溅射工作压强为 2Pa ,工作气体为氧气,工作气体的流量为 25sccm ,衬底温度为 500°C ,溅射功率 100W 。

7. 一种薄膜电致发光器件,该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层,其特征在于,所述发光层的材料为钐掺杂氮化硅发光材料,该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

8. 一种薄膜电致发光器件的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

提供具有阳极的衬底;

在所述阳极上形成发光层,所述发光层的材料为钐掺杂氮化硅发光材料,该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;

在所述发光层上形成阴极。

9. 根据权利要求 8 所述的薄膜电致发光器件的制备方法,其特征在于,所述发光层的制备包括以下步骤:

根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时~ 5 小时制成靶材,其中 x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、

镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种；

将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体，并将真空腔体的真空度设置为 1.0×10^{-3} Pa \sim 1.0×10^{-5} Pa；

调整磁控溅射镀膜工艺参数为：基靶间距为 45mm \sim 95mm，磁控溅射工作压强 0.2Pa \sim 4Pa，工作气体的流量为 10sccm \sim 35sccm，衬底温度为 250°C \sim 750°C，溅射功率 80 \sim 300W，接着进行制膜，在所述阳极上形成发光层。

10. 根据权利要求 9 所述的薄膜电致发光器件的制备方法，其特征在于，所述 Me_3N_2 ， Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为 2 : 5 : (0.03 \sim 0.15)。

钐掺杂氮化硅发光材料、制备方法及其应用

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种钐掺杂氮化硅发光材料、其制备方法、钐掺杂氮化硅发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法。

【背景技术】

[0002] 薄膜电致发光显示器 (TFELD) 由于其主动发光、全固体化、耐冲击、反应快、视角大、适用温度宽、工序简单等优点, 已引起了广泛的关注, 且发展迅速。目前, 研究彩色及至全色 TFELD, 开发多波段发光的材料, 是该课题的发展方向。但是, 可应用于薄膜电致发光显示器的钐掺杂氮化硅发光材料, 仍未见报道。

【发明内容】

[0003] 基于此, 有必要提供一种可应用于薄膜电致发光器件的钐掺杂氮化硅发光材料、其制备方法、钐掺杂氮化硅发光薄膜、其制备方法、使用该钐掺杂氮化硅发光材料的薄膜电致发光器件及其制备方法。

[0004] 一种钐掺杂氮化硅发光材料, 其化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$, 其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0005] 一种钐掺杂氮化硅发光材料的制备方法, 包括以下步骤:

[0006] 根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀, 其中, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种; 及

[0007] 将混合均匀的粉体在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时即得到化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 的钐掺杂氮化硅发光材料。

[0008] 一种钐掺杂氮化硅发光薄膜, 该钐掺杂氮化硅发光薄膜的材料的化学通式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$, 其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0009] 一种钐掺杂氮化硅发光薄膜的制备方法, 包括以下步骤:

[0010] 根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材, 其中, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;

[0011] 将所述靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$; 及

[0012] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 $45\text{mm} \sim 95\text{mm}$, 磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 4\text{Pa}$, 工作气体的流量为 $10\text{sccm} \sim 35\text{sccm}$, 衬底温度为 $250^\circ\text{C} \sim 750^\circ\text{C}$, 溅射功率 $80 \sim 300\text{W}$, 接着进行制膜, 得到化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 的钐掺杂氮化硅发光薄膜。

[0013] 所述 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为 $2:5:(0.03 \sim 0.15)$ 。

[0014] 所述真空腔体的真空度为 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$, 基靶间距为 60mm , 磁控溅射工作压强为

2Pa, 工作气体为氧气, 工作气体的流量为 25sccm, 衬底温度为 500℃, 溅射功率 100W。

[0015] 一种薄膜电致发光器件, 该薄膜电致发光器件包括依次层叠的衬底、阳极层、发光层以及阴极层, 所述发光层的材料为钐掺杂氮化硅发光材料, 该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$, 其中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 0.01 ~ 0.05, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0016] 一种薄膜电致发光器件的制备方法, 包括以下步骤:

[0017] 提供具有阳极的衬底;

[0018] 在所述阳极上形成功发光层, 所述发光层的材料为钐掺杂氮化硅发光材料, 该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$, 其中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 0.01 ~ 0.05, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;

[0019] 在所述发光层上形成阴极。

[0020] 在优选的实施例中, 所述发光层的制备包括以下步骤:

[0021] 根据 $Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在 900℃ ~ 1300℃ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材, 其中 x 为 0.01 ~ 0.05, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种;

[0022] 将所述靶材以及所述衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空气度设置为 $1.0 \times 10^{-3}Pa \sim 1.0 \times 10^{-5}Pa$;

[0023] 调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 45mm ~ 95mm, 磁控溅射工作压强 0.2Pa ~ 4Pa, 工作气体的流量为 10sccm ~ 35sccm, 衬底温度为 250℃ ~ 750℃, 溅射功率 80 ~ 300W, 接着进行制膜, 在所述阳极上形成功发光层。

[0024] 所述 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为 2:5:(0.03 ~ 0.15)。

[0025] 上述钐掺杂氮化硅发光材料($Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$)制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中, 在 638nm 和 727nm 波长区都有很强的发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

【附图说明】

[0026] 图 1 为一实施方式的薄膜电致发光器件的结构示意图;

[0027] 图 2 为实施例 1 制备的钐掺杂氮化硅发光薄膜的电致发光光谱图;

[0028] 图 3 为实施例 1 制备的钐掺杂氮化硅发光薄膜的 XRD 图;

[0029] 图 4 是实施例 1 制备的薄膜电致发光器件的电压与电流密度和电压与亮度之间的关系曲线图。

【具体实施方式】

[0030] 下面结合附图和具体实施例对钐掺杂氮化硅发光材料、其制备方法、钐掺杂氮化硅发光薄膜、其制备方法、薄膜电致发光器件及其制备方法进一步阐明。

[0031] 一实施方式的钐掺杂氮化硅发光材料, 其化学式为 $Me_2Si_5N_8 : xSm^{3+}$, 其中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 0.01 ~ 0.05, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0032] 优选的, x 为 0.03。

[0033] 该钐掺杂氮化硅发光材料中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质, 钐离子是激活元素。该钐掺杂氮化

硅发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中,在638nm和727nm波长区都有很强的发光峰,能够应用于薄膜电致发光显示器中。

[0034] 上述钐掺杂氮化硅发光材料的制备方法,包括以下步骤:

[0035] 步骤S11、根据 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 、 Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀,其中,x为0.01~0.05,Me为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0036] 该步骤中,优选的,x为0.03。

[0037] 步骤S12、将混合均匀的粉体在900℃~1300℃下烧结0.5小时~5小时即可得到钐掺杂氮化硅发光材料,其化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 的钐掺杂氮化硅。

[0038] 该步骤中,优选的在1250℃下烧结3小时。

[0039] 一实施方式的钐掺杂氮化硅发光薄膜,该钐掺杂氮化硅发光薄膜的化学通式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素,x为0.01~0.05,Me为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0040] 优选的,x为0.03。

[0041] 上述钐掺杂氮化硅发光薄膜的制备方法,包括以下步骤:

[0042] 步骤S21、按 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 、 Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在900℃~1300℃下烧结0.5小时~5小时制成靶材,其中,x为0.01~0.05,Me为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0043] 该步骤中,优选的,x为0.03,在1250℃下烧结3小时成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材。

[0044] 该步骤中,优选的,所述 Me_3N_2 、 Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为2:5:(0.03~0.15)。

[0045] 步骤S22、将步骤S21中得到的靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体,并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0046] 该步骤中,优选的,真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。

[0047] 步骤S23、调整磁控溅射镀膜工艺参数为:基靶间距为45mm~95mm,磁控溅射工作压强0.2Pa~4Pa,工作气体的流量为10sccm~35sccm,衬底温度为250℃~750℃,溅射功率80~300W,接着进行制膜,得到化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 钐掺杂氮化硅发光薄膜。

[0048] 该步骤中,优选的基靶间距为60mm,磁控溅射工作压强2Pa,工作气体为氧气,工作气体的流量为25sccm,衬底温度为500℃,溅射功率100W。

[0049] 请参阅图1,一实施方式的薄膜电致发光器件100,该薄膜电致发光器件100包括依次层叠的衬底1、阳极2、发光层3以及阴极4。

[0050] 衬底1为玻璃衬底。阳极2为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡(ITO)。发光层3的材料为钐掺杂氮化硅发光材料,该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$,其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质,钐离子是激活元素,x为0.01~0.05,Me为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。阴极4的材质为银(Ag)。

[0051] 上述薄膜电致发光器件的制备方法,包括以下步骤:

[0052] 步骤S31、提供具有阳极2的衬底1。

[0053] 本实施方式中,衬底1为玻璃衬底,阳极2为形成于玻璃衬底上的氧化铟锡(ITO)。具有阳极2的衬底1先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗并用对其进行氧等离子处

理。

[0054] 步骤 S32、在阳极 2 上形成发光层 3, 发光层 3 的材料为钐掺杂氮化硅发光材料, 该钐掺杂氮化硅发光材料的化学式为 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$, 其中 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质, 钐离子是激活元素, x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0055] 本实施方式中, 发光层 3 由以下步骤制得:

[0056] 首先, 将 $\text{Me}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : x\text{Sm}^{3+}$ 各元素的化学计量比称取 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体并混合均匀在 $900^\circ\text{C} \sim 1300^\circ\text{C}$ 下烧结 0.5 小时 ~ 5 小时制成靶材, 其中 x 为 $0.01 \sim 0.05$, Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。

[0057] 该步骤中, 优选的, x 为 0.03 , 在 1250°C 下烧结 3 小时成直径为 50mm , 厚度为 2mm 的陶瓷靶材。

[0058] 该步骤中, 优选的, 所述 Me_3N_2 , Si_3N_4 和 SmN 粉体的摩尔比为 $2:5:(0.03 \sim 0.15)$ 。

[0059] 其次, 将靶材以及衬底装入磁控溅射镀膜设备的真空腔体, 并将真空腔体的真空度设置为 $1.0 \times 10^{-3}\text{Pa} \sim 1.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$ 。

[0060] 该步骤中, 优选的, 真空度为 $5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 。

[0061] 然后, 调整磁控溅射镀膜工艺参数为: 基靶间距为 $45\text{mm} \sim 95\text{mm}$, 磁控溅射工作压强 $0.2\text{Pa} \sim 4\text{Pa}$, 工作气体的流量为 $10\text{sccm} \sim 35\text{sccm}$, 衬底温度为 $250^\circ\text{C} \sim 750^\circ\text{C}$, 溅射功率 $80 \sim 300\text{W}$, 接着进行制膜, 在阳极 2 上形成发光层 3。

[0062] 该步骤中, 优选的基靶间距为 60mm , 磁控溅射工作压强 2Pa , 工作气体为氧气, 工作气体的流量为 25sccm , 衬底温度为 500°C , 溅射功率 100W 。

[0063] 步骤 S33、在发光层 3 上形成阴极 4。

[0064] 本实施方式中, 阴极 4 的材料为银(Ag), 由蒸镀形成。

[0065] 下面为具体实施例。

[0066] 实施例 1

[0067] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Zn_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.09mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 1250°C 下烧结成直径为 50mm , 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm 。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 $5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$, 氧气的工作气体流量为 25sccm , 压强调节为 2.0Pa , 衬底温度为 500°C , 溅射功率 100W , 得到化学式为 $\text{Zn}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.03\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0068] 本实施例中得到的钐掺杂氮化硅发光薄膜的化学通式为 $\text{Zn}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.03\text{Sm}^{3+}$, 其中 $\text{Zn}_2\text{Si}_5\text{N}_8$ 是基质, Sm^{3+} 是激活元素。

[0069] 请参阅图 2, 图 2 所示为得到的钐掺杂氮化硅发光薄膜的电致发光谱(EL)。由图 2 可以看出, 电致发光谱中, 在 638nm 和 727nm 波长区都有很强的发光峰, 能够应用于薄膜电致发光显示器中。

[0070] 请参阅图 3, 图 3 为实施例 1 制备的钐掺杂氮化硅发光薄膜的 XRD 曲线, 测试对照标准 PDF 卡片。从图 3 中可以看出图中的衍射峰是氮化硅的结晶峰, 没有出现掺杂元素以及其它杂质的衍射峰; 说明该制备方法得到的产品具有良好的结晶质量。

[0071] 请参阅图 4, 图 4 是实施例 1 制备的薄膜电致发光器件的电压与电流密度和电压与

亮度之间的关系曲线图,曲线1是电压与电流密度关系曲线,可看出该器件从电压5.0V开始发光,曲线2是电压与亮度关系曲线,可以看出该器件的最大亮度为88cd/m²,表明器件具有良好的发光特性。

[0072] 实施例2

[0073] 选用纯度为99.99%的粉体,将2mmol的Zn₃N₂,5mmol的Si₃N₄,0.03mmol的SmN粉体,经过均匀混合后,在900℃下烧结成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带ITO的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa,氧气的工作气体流量为10sccm,压强调节为0.5Pa,衬底温度为250℃,溅射功率80W。得到化学式为Zn₂Si₅N₈ : 0.01Sm³⁺的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层Ag,作为阴极。

[0074] 实施例3

[0075] 选用纯度为99.99%的粉体,将2mmol的Zn₃N₂,5mmol的Si₃N₄,0.15mmol的SmN粉体,经过均匀混合后,在1300℃下烧结成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带ITO的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa,氩气的工作气体流量为35sccm,压强调节为4.0Pa,衬底温度为750℃,溅射功率300W。得到化学式为Zn₂Si₅N₈ : 0.05Sm³⁺的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层Ag,作为阴极。

[0076] 实施例4

[0077] 选用纯度为99.99%的粉体,将2mmol的Mg₃N₂,5mmol的Si₃N₄,0.09mmol的SmN粉体,经过均匀混合后,在1250℃下烧结成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带ITO的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 5.0×10^{-4} Pa,氧气的工作气体流量为25sccm,压强调节为2.0Pa,衬底温度为500℃,溅射功率100W。得到化学式为Mg₂Si₅N₈ : 0.03Sm³⁺的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层Ag,作为阴极。

[0078] 实施例5

[0079] 选用纯度为99.99%的粉体,将2mmol的Mg₃N₂,5mmol的Si₃N₄,0.03mmol的SmN粉体,经过均匀混合后,在900℃下烧结成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带ITO的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa,氧气的工作气体流量为10sccm,压强调节为0.5Pa,衬底温度为250℃,溅射功率为80W。得到化学式为Mg₂Si₅N₈ : 0.01Sm³⁺的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层Ag,作为阴极。

[0080] 实施例6

[0081] 选用纯度为99.99%的粉体,将2mmol的Mg₃N₂,5mmol的Si₃N₄,0.15mmol的SmN粉体,经过均匀混合后,在1300℃下烧结成直径为50mm,厚度为2mm的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带ITO的玻璃衬底,并用

对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 氧气的工作气体流量为 35sccm, 压强调节为 4.0Pa, 衬底温度为 750°C, 溅射功率 300W。得到化学式为 $Mg_2Si_5N_8 : 0.05Sm^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0082] 实施例 7

[0083] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Ca_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.09mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 1250°C 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 5.0×10^{-4} Pa, 氧气的工作气体流量为 25sccm, 压强调节为 2.0Pa, 衬底温度为 500°C, 溅射功率 100W。得到化学通式为 $Ca_2Si_5N_8 : 0.03Sm^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0084] 实施例 8

[0085] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Ca_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.03mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 900°C 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa, 氧气的工作气体流量为 10sccm, 压强调节为 0.5Pa, 衬底温度为 250°C, 溅射功率为 80W。得到化学式为 $Ca_2Si_5N_8 : 0.01Sm^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0086] 实施例 9

[0087] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Ca_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.15mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 1300°C 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa, 氧气的工作气体流量为 35sccm, 压强调节为 4.0Pa, 衬底温度为 750°C, 溅射功率 300W。得到化学式为 $Ca_2Si_5N_8 : 0.05Sm^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0088] 实施例 10

[0089] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Sr_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.09mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 1250°C 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入真空腔体内。然后, 先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底, 并用对其进行氧等离子处理, 放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 5.0×10^{-4} Pa, 氧气的工作气体流量为 25sccm, 压强调节为 2.0Pa, 衬底温度为 500°C, 溅射功率 100W。得到化学通式为 $Sr_2Si_5N_8 : 0.03Sm^{3+}$ 的发光薄膜, 然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag, 作为阴极。

[0090] 实施例 11

[0091] 选用纯度为 99.99% 的粉体, 将 2mmol 的 Sr_3N_2 , 5mmol 的 Si_3N_4 , 0.03mmol 的 SmN 粉体, 经过均匀混合后, 在 900°C 下烧结成直径为 50mm, 厚度为 2mm 的陶瓷靶材, 并将靶材装入

真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa,氧气的工作气体流量为 10sccm,压强调节为 0.5Pa,衬底温度为 250℃,溅射功率为 80W。得到化学式为 $\text{Sr}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.01\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag,作为阴极。

[0092] 实施例 12

[0093] 选用纯度为 99.99% 的粉体,将 2mmol 的 Sr_3N_2 ,5mmol 的 Si_3N_4 ,0.15mmol 的 SmN 粉体,经过均匀混合后,在 1300℃下烧结成直径为 50mm,厚度为 2mm 的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa,氧气的工作气体流量为 35sccm,压强调节为 4.0Pa,衬底温度为 750℃,溅射功率 300W。得到化学式为 $\text{Sr}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.05\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag,作为阴极。

[0094] 实施例 13

[0095] 选用纯度为 99.99% 的粉体,将 2mmol 的 Ba_3N_2 ,5mmol 的 Si_3N_4 ,0.09mmol 的 SmN 粉体,经过均匀混合后,在 1250℃下烧结成直径为 50mm,厚度为 2mm 的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 60mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 5.0×10^{-4} Pa,氧气的工作气体流量为 25sccm,压强调节为 2.0Pa,衬底温度为 500℃,溅射功率 100W。得到化学通式为 $\text{Ba}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.03\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag,作为阴极。

[0096] 实施例 14

[0097] 选用纯度为 99.99% 的粉体,将 2mmol 的 Ba_3N_2 ,5mmol 的 Si_3N_4 ,0.03mmol 的 SmN 粉体,经过均匀混合后,在 900℃下烧结成直径为 50mm,厚度为 2mm 的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 45mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-3} Pa,氧气的工作气体流量为 10sccm,压强调节为 0.5Pa,衬底温度为 250℃,溅射功率为 80W。得到化学式为 $\text{Ba}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.01\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag,作为阴极。

[0098] 实施例 15

[0099] 选用纯度为 99.99% 的粉体,将 2mmol 的 Ba_3N_2 ,5mmol 的 Si_3N_4 ,0.15mmol 的 SmN 粉体,经过均匀混合后,在 1300℃下烧结成直径为 50mm,厚度为 2mm 的陶瓷靶材,并将靶材装入真空腔体内。然后,先后用丙酮、无水乙醇和去离子水超声清洗带 ITO 的玻璃衬底,并用对其进行氧等离子处理,放入真空腔体。把靶材和衬底的距离设定为 95mm。用机械泵和分子泵把腔体的真空度抽到 1.0×10^{-5} Pa,氧气的工作气体流量为 35sccm,压强调节为 4.0Pa,衬底温度为 750℃,溅射功率 300W。得到化学式为 $\text{Ba}_2\text{Si}_5\text{N}_8 : 0.05\text{Sm}^{3+}$ 的发光薄膜,然后在发光薄膜上面蒸镀一层 Ag,作为阴极。

[0100] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员

来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

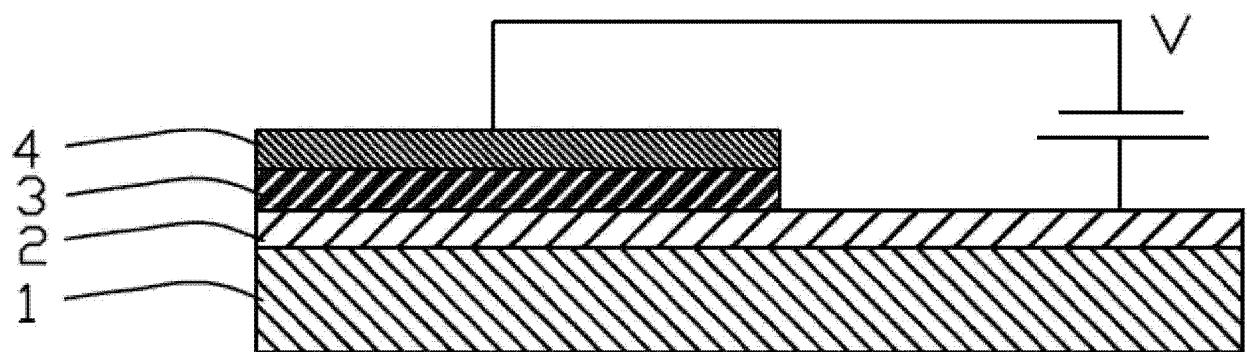


图 1

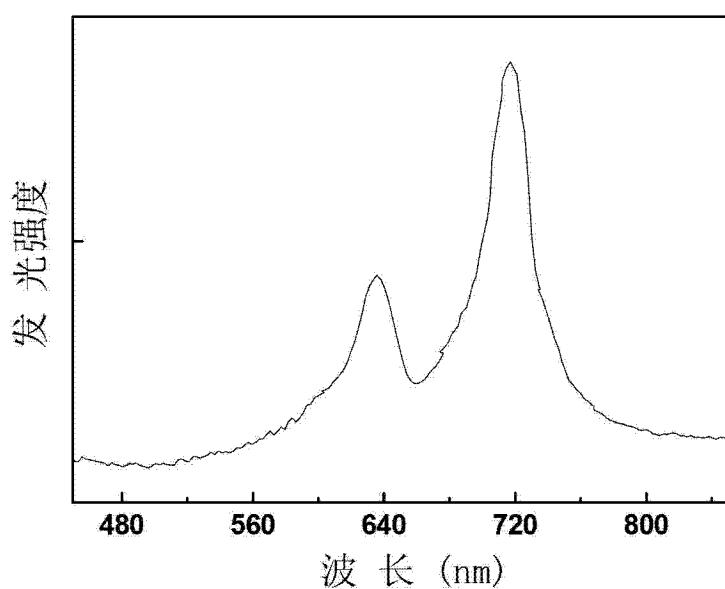


图 2

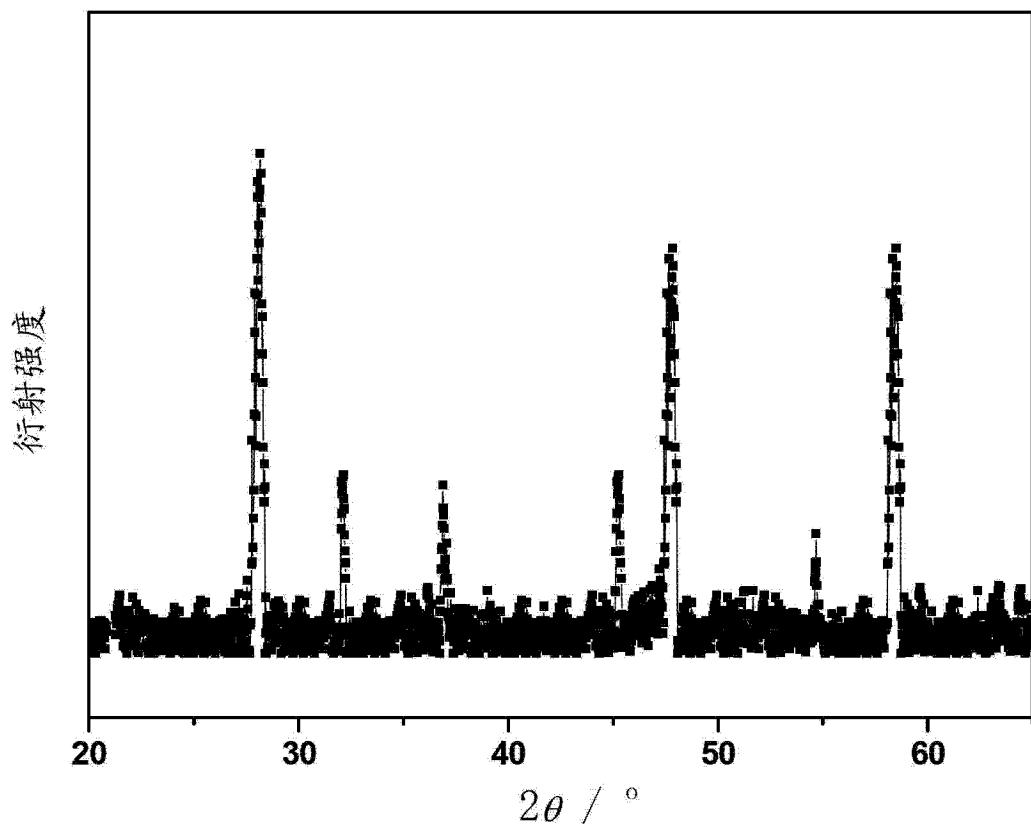


图 3

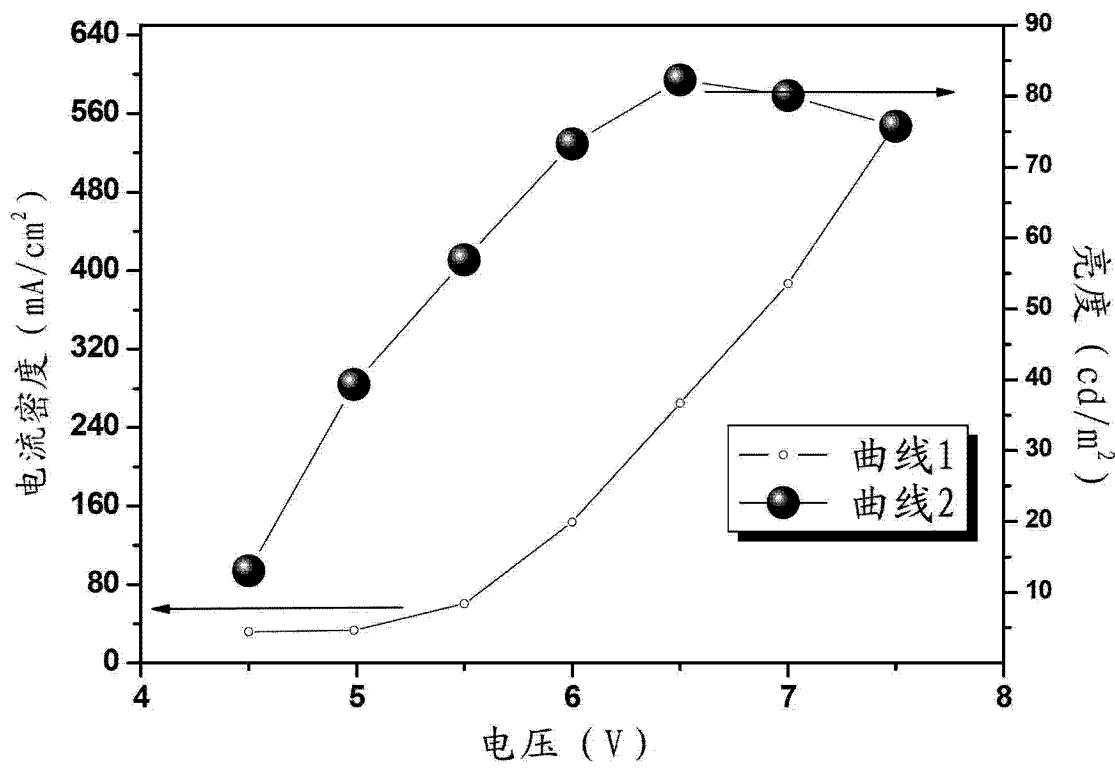


图 4

专利名称(译)	钐掺杂氮化硅发光材料、制备方法及其应用		
公开(公告)号	CN104119864A	公开(公告)日	2014-10-29
申请号	CN201310150177.5	申请日	2013-04-26
[标]申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	海洋王照明科技股份有限公司 深圳市海洋王照明技术有限公司 深圳市海洋王照明工程有限公司		
[标]发明人	周明杰 陈吉星 王平 张振华		
发明人	周明杰 陈吉星 王平 张振华		
IPC分类号	C09K11/59 H01L51/54 H01L51/56		
代理人(译)	熊永强		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

一种钐掺杂氮化硅发光材料，其化学式为 $Me_2Si_5N_8:xSm^{3+}$ ，其中 $Me_2Si_5N_8$ 是基质，钐离子是激活元素， x 为 $0.01 \sim 0.05$ ， Me 为锌元素、镁元素、钙元素、锶元素和钡元素中的一种。该钐掺杂氮化硅发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中，在 $638nm$ 和 $727nm$ 波长区都有很强的发光峰，能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该钐掺杂氮化硅发光材料的制备方法及其应用。

